

Revendications

1. Procédé de collage d'un premier substrat (100) et d'un second substrat (200), comprenant la mise en contact desdits premier et second substrats et la mise en œuvre d'un chauffage d'une zone périphérique d'au moins un desdits premier et second substrats, ledit chauffage étant initié avant la mise en contact des substrats et prolongé au moins jusqu'à la mise en contact des substrats dans ladite zone, ledit procédé étant caractérisé en ce que le chauffage est mis en œuvre au moyen d'une lampe infrarouge (2) configurée pour émettre un rayonnement présentant une limite extérieure correspondant au bord desdits substrats.
2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel les premier et second substrats présentent une forme circulaire et la lampe infrarouge présente une forme en arc de cercle dont le diamètre est inférieur ou égal au diamètre desdits substrats.
3. Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, dans lequel le premier et le second substrat sont maintenus par un support (3) présentant une région périphérique (30) s'étendant autour du bord desdits substrats, la lampe infrarouge (2) étant agencée de sorte à chauffer la zone périphérique du premier et/ou du second substrat à l'exclusion de la région périphérique (30) dudit support.
4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel le chauffage se termine au plus tard à la fin de la propagation de l'onde de collage entre les substrats.
5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel la lampe infrarouge (2) émet un rayonnement dans une gamme de longueur d'onde adapté pour une absorption dudit rayonnement par de l'eau présente entre les substrats (100, 200).
6. Procédé de transfert d'une couche semi-conductrice d'un premier substrat semi-conducteur, dit substrat donneur (100), sur un second substrat, dit substrat receveur (200), comprenant :
- la formation d'une zone de fragilisation (101) dans le substrat donneur (100), de sorte à délimiter une couche semi-conductrice (1) à transférer,
 - la fourniture d'un substrat receveur (200), l'un au moins du substrat donneur et du substrat receveur étant recouvert d'une couche électriquement isolante (102),

- le collage du premier substrat (100) et du substrat receveur (200) par le procédé selon l'une des revendications 1 à 5, la couche électriquement isolante (102) étant à l'interface de collage,
 - le détachement du substrat donneur (100) le long de la zone de fragilisation (101), de sorte à transférer la couche semi-conductrice (1) sur le substrat receveur (200).
7. Installation pour le collage d'un premier substrat et d'un second substrat, comprenant un support (3) configuré pour maintenir lesdits premier et second substrats lors de leur mise en contact, ledit support présentant une région périphérique (30) s'étendant autour du bord desdits substrats, et une lampe agencée en regard d'une zone périphérique d'au moins un desdits premier et second substrats, ladite installation étant caractérisée en ce que la lampe est une lampe infrarouge (2) configurée pour émettre un rayonnement présentant une limite extérieure correspondant au bord desdits substrats, de sorte à ne pas exposer la région périphérique (30) du support (3) audit rayonnement.
8. Installation selon la revendication 7, dans laquelle la lampe infrarouge est adaptée pour émettre une onde de type moyenne rapide.
9. Installation selon l'une des revendications 7 ou 8, dans laquelle la lampe infrarouge comprend un filament adapté pour être porté à une température d'environ 1600°C lors du fonctionnement de la lampe.
10. Installation selon l'une des revendications 7 à 9, dans laquelle la lampe infrarouge présente un pic de puissance pour une longueur d'onde comprise entre 1,5 et 2 μm .